

DTC143TKA

Rev.F Apr.-2017

描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装 硅 NPN 数字三极管。Silicon NPN Digital transistor in a SOT-23 Plastic Package.

特征 / Features

内装偏置电阻，简化线路设计，减少元件和制造流程。

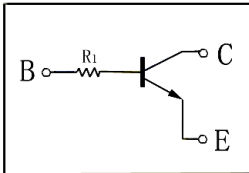
With built-in bias resistors, simplify circuit design, reduce a quantity of parts and manufacturing process.

用途 / Applications

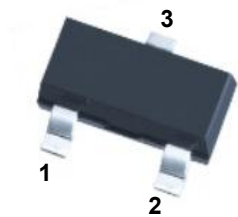
用于开关、反相电路、界面电路以及驱动电路中。

Switching, inverter circuit, interface circuit and driver circuit applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN 1 : Base

PIN 2 : Emitter

PIN 3 : Collector

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

Marking	H03
---------	-----

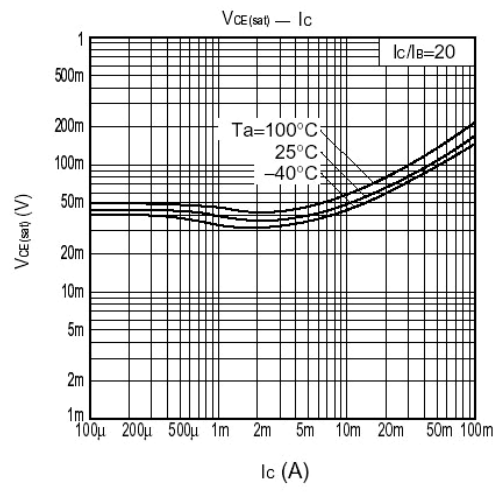
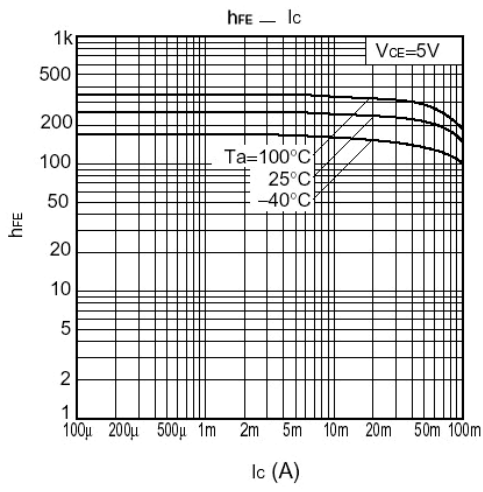
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	50	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	50	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current	I_C	100	mA
Power Dissipation	P_C	200	mW
Junction Temperature	T_J	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	$I_C=50\mu A$	50			V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	$I_C=1.0mA$	50			V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	$I_E=50\mu A$	5.0			V
Collector Cut-off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=50V$			0.5	μA
Emitter Cut-off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=4.0V$			0.5	μA
DC Current Gain	h_{FE}	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=1.0mA$	100	250	600	
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5.0mA$ $I_B=0.25mA$			0.3	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=10V$ $I_C=5.0mA$ $f_T=100MHz$		250		MHz
Resistance1	R1		3.29	4.7	6.11	K Ω

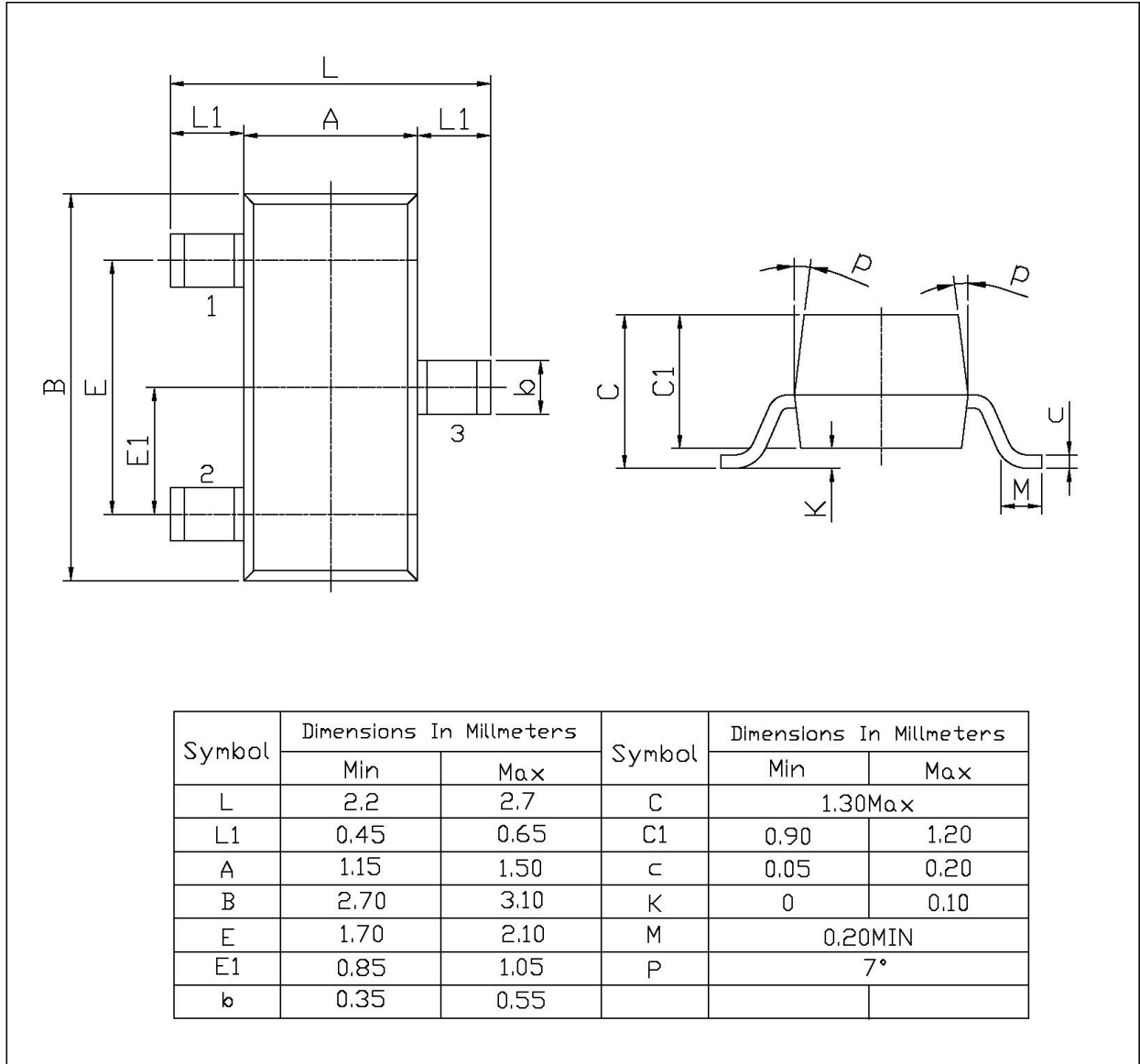
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



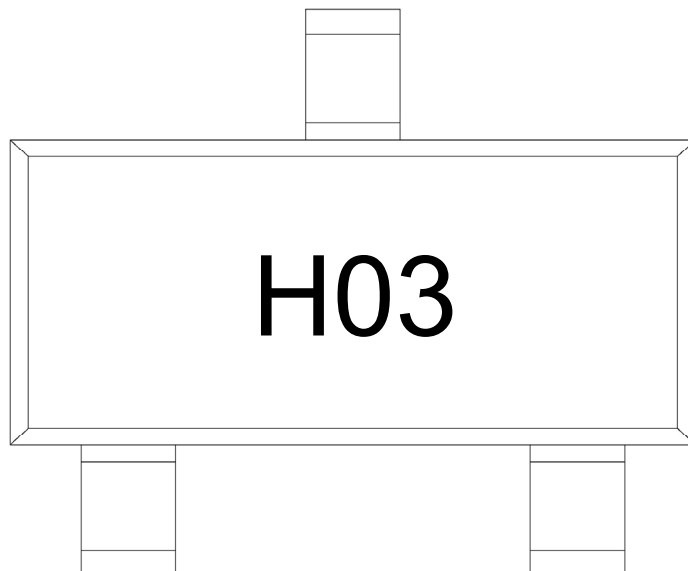
外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-23

单位: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

H： 为公司代码

03： 为型号代码

Note:

H： Company Code

03： Product Type

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" x8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - Pre-Biased](#) category:

Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[RN1607\(TE85L,F\)](#) [DRC9A14E0L](#) [DTA124GKAT146](#) [DTA144WETL](#) [DTA144WKAT146](#) [DTC113EET1G](#) [DTC115TETL](#)
[DTC115TKAT146](#) [DTC124TETL](#) [DTC144VUAT106](#) [MUN5241T1G](#) [BCR158WH6327XTSA1](#) [NSBA114TDP6T5G](#) [NSBA123EF3T5G](#)
[NSBA143TF3T5G](#) [NSBA144TF3T5G](#) [NSBC113EF3T5G](#) [NSBC124XF3T5G](#) [SMUN5330DW1T1G](#) [SSVMUN5312DW1T2G](#)
[RN1303\(TE85L,F\)](#) [RN1306\(TE85L,F\)](#) [RN4605\(TE85L,F\)](#) [BCR129SH6327XTSA1](#) [TTEPROTOTYPE79](#) [DTA113EET1G](#) [EMH15T2R](#)
[SMUN2214T3G](#) [SMUN5335DW1T1G](#) [NSBA124XF3T5G](#) [NSBC123EF3T5G](#) [NSBC143ZPDP6T5G](#) [NSBC144TF3T5G](#)
[NSVMUN5113DW1T3G](#) [SMUN5230DW1T1G](#) [SMUN2214T1G](#) [FMA7AT148](#) [DTC114EUA-TP](#) [NSVDTA114EET1G](#)
[SMUN5237DW1T1G](#) [SMUN5233T1G](#) [SMUN5213DW1T1G](#) [SMUN5114DW1T1G](#) [SMUN5113T1G](#) [SMUN2111T1G](#) [DTC124ECA-TP](#)
[DTC123TM3T5G](#) [DTA114ECA-TP](#) [DTA113EM3T5G](#) [DTC113EM3T5G](#)